








	<p>IPD50N06S4L08ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD50N06S4L08ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  IPD50N06S4L08ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD50N06S4L08ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 35µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4780pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD50N06S4L08ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50N06S4L08ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50N06S4L08ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD50N06S4L08ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD50N08S413ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD50N06S409ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50N06S4L08ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50N06S409ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3</p>
 <p>IPD50N10S3L-16 I IPD50N10S3L-16 I</p>	 <p>IPD50N06S4L12ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50N06S4L-08 INFINEO IPD50N06S4L-08 INFINEO</p>	 <p>IPD50N06S4-12 infineom IPD50N06S4-12 infineom</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50N06S4L08ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50N06S4L08ATMA1 Datenblatt	IPD50N06S4L08ATMA1-Datenblätter	IPD50N06S4L08ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50N06S4L08ATMA1
IPD50N06S4L08ATMA1 Electronic	IPD50N06S4L08ATMA1-Komponenten	IPD50N06S4L08ATMA1-Verteiler	IPD50N06S4L08ATMA1-Bild	IPD50N06S4L08ATMA1-Teil
IPD50N06S4L08ATMA1 Preis	IPD50N06S4L08ATMA1 Hersteller	IPD50N06S4L08ATMA1 Bild	IPD50N06S4L08ATMA1 Aktie	IPD50N06S4L08ATMA1 Inventar
IPD50N06S4L08ATMA1 Neu	IPD50N06S4L08ATMA1 Original	IPD50N06S4L08ATMA1 garantiert	IPD50N06S4L08ATMA1 RFQ	IPD50N06S4L08ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited